

### 产品介绍

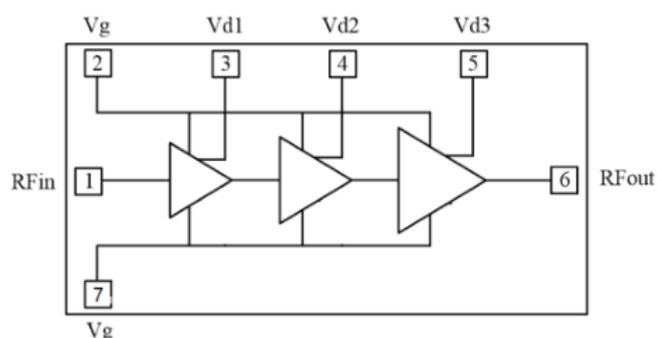
YGPA26-0206C1 是一款基于GaN HEMT晶体管实现的高功率放大器芯片，采用GaN功率MMIC工艺制作。工作频率范围覆盖2GHz~6GHz，功率增益24dB，典型饱和输出功率12W，典型功率附加效率43%，可在连续波、脉冲模式下工作。芯片通过背面通孔接地，双电源工作，典型工作电压Vd=+28V，Vg=-2.2V。

### 关键技术指标

- 频率范围：2GHz~6GHz
- 功率增益：24dB
- 饱和输出功率：41dBm
- 功率附加效率：43%
- 供电：+28V@ 1.2A（静态）
- 芯片尺寸：2.80mm×2.10mm×0.08mm

### 应用领域

- 微波收发组件
- 固态发射机



YGPA26-0206C1 功能框图

**直流电参数 (T<sub>A</sub> = +25°C)**

指标	符号	最小值	典型值	最大值	单位
栅极工作电压	V <sub>g</sub>	-3.0	-2.2	-1.8	V
漏极工作电压	V <sub>d</sub>	-	28	-	V
静态漏极电流	I <sub>d</sub>	-	1.2	-	A
动态漏极电流	I <sub>dd</sub>	-	1.2	1.5	A
动态栅极电流	I <sub>gg</sub>	-	1	5	mA

**微波电参数 (T<sub>A</sub> = +25°C, V<sub>d</sub> = +28V, V<sub>g</sub> = -2.2V)**

指标	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	f	2~6			GHz
饱和输出功率	P <sub>sat</sub>	41	41.5	-	dBm
功率增益	G <sub>p</sub>	24	24.5	-	dB
功率增益平坦度	ΔG <sub>p</sub>	-	-	±0.5	dB
功率附加效率	PAE	-	43	-	%

注：1) 芯片均经过在片 100% 直流测试，100% 射频测试；

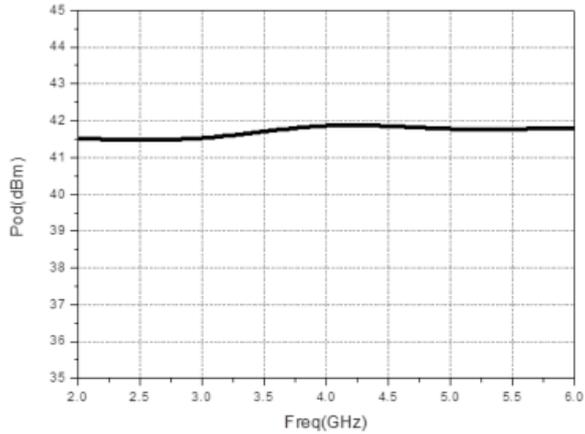
2) 除特殊说明外，该手册的曲线测试条件均为：V<sub>d</sub>=+28V, V<sub>g</sub>=-2.2V, P<sub>in</sub>=17dBm, 脉宽 100μs, 占空比 10%

**使用限制参数**

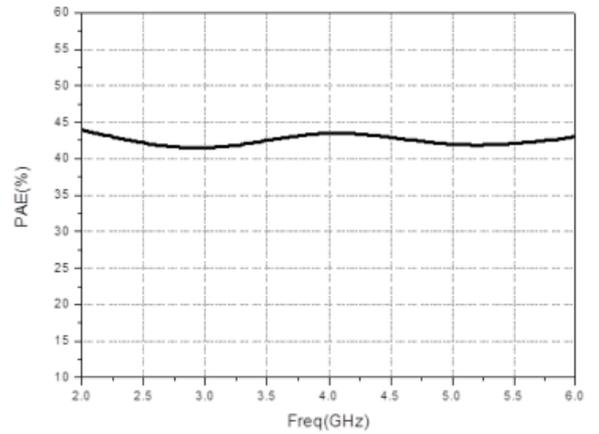
参数	符号	极限值
最大漏源电压	V <sub>d</sub>	+32V
最小栅源电压	V <sub>g</sub>	-5V
最高输入功率 (CW)	P <sub>p</sub>	+23dBm
储存温度	T <sub>STG</sub>	-65°C ~ +150°C
最高工作沟道温度	T <sub>OP</sub>	+225°C
负载阻抗失配 (抗烧毁)	Z <sub>0</sub>	7: 1

典型曲线 (Vd=+28V, Vg=-2.2V)

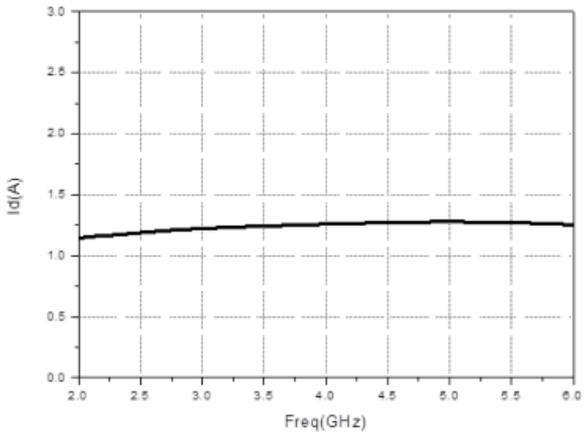
饱和输出功率 vs. 频率 (Pin=17dBm)



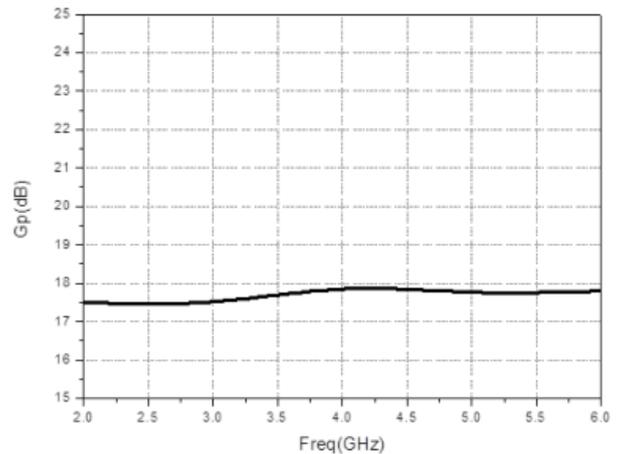
附加效率 vs. 频率 (Pin=17dBm)



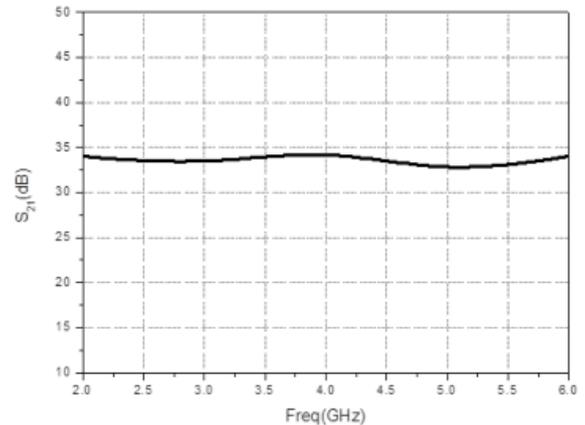
动态漏极电流 vs. 频率 (Pin=17dBm)



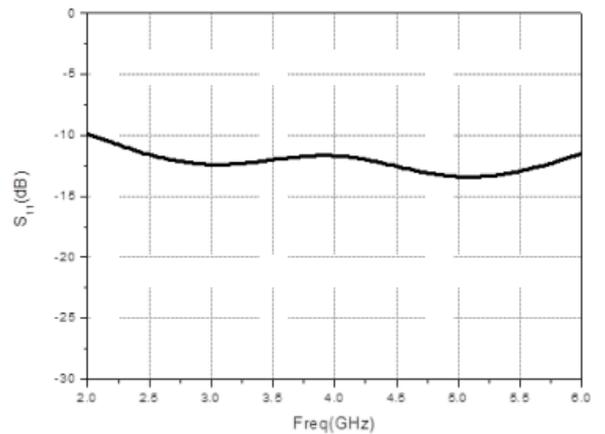
功率增益 vs. 频率 (Pin=17dBm)



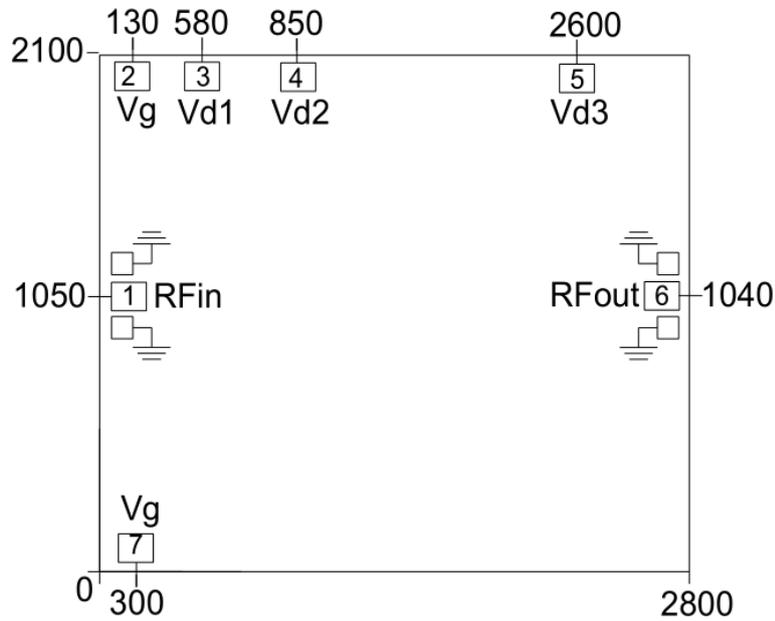
小信号增益 vs. 频率 (Pin=-10dBm)



输入驻波 vs. 频率 (Pin=-10dBm)



## 外形尺寸



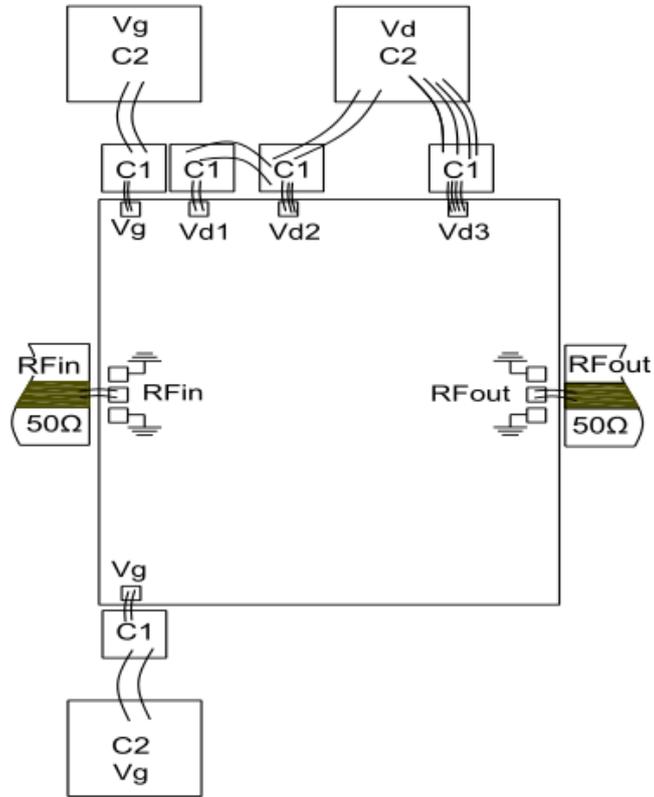
注:

图中单位均为微米( $\mu\text{m}$ ); 外形尺寸公差 $\pm 50\mu\text{m}$ 。

## 压点排序图

序列号	功能符号	功能描述	尺寸
1	RFIn	信号输入端	100 $\mu\text{m}$ x150 $\mu\text{m}$
2、7	Vg	栅极电源端	130 $\mu\text{m}$ x100 $\mu\text{m}$
3	Vd1	漏极电源端	140 $\mu\text{m}$ x100 $\mu\text{m}$
4	Vd2	漏极电源端	120 $\mu\text{m}$ x80 $\mu\text{m}$
5	Vd3	漏极电源端	150 $\mu\text{m}$ x130 $\mu\text{m}$
6	RFout	信号输出端	100 $\mu\text{m}$ x150 $\mu\text{m}$

## 建议装配图



- 注:
- 1) 外围电容的容值为  $C1=100\text{pF}$ ,  $C2=1000\text{pF}$  推荐使用单层陶瓷电容, 其中  $C1$  应尽量靠近芯片, 不要超过  $750\mu\text{m}$ 。
  - 2) 考虑  $125\mu\text{m}\sim 250\mu\text{m}$  的低损低介电常数材料微带线粘接/烧结在载体上, 以降低传输损耗, 输入输出键合金丝长度控制在  $350\mu\text{m}\pm 150\mu\text{m}$  以内。

## 注意事项

1. 单片电路需贮存在干燥洁净的N2环境中；
2. 芯片衬底6H-SiC材料很脆，使用时必须小心，以免损伤芯片；
3. 芯片表面没有绝缘保护层，需注意装配环境洁净度，避免表面过度沾污；
4. 载体的热膨胀系数应与6H-SiC材料接近，线热膨胀系数 $4.2 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ,建议载体材料选用CuMoCu或CuMo或CuW；
5. 装配时芯片与载体之间要避免孔洞，同时保证盒体和载体的良好散热；
6. 建议用金锡焊料烧结，Au:Sn=80%:20%,烧结温度不超过300℃，时间不长于30秒，烧结工艺避免温度快速变化，需要逐步升降温；
7. 建议使用直径25 $\mu\text{m}$ ~30 $\mu\text{m}$ 金丝，键合台底盘温度不超过250℃，键合时间尽量短，键合工艺避免温度快速变化；
8. 上电时先加栅压后加漏压，去电时先降漏压后降栅压；
9. 芯片内部输入输出有隔直电容，但输入端有直流对地短路结构；
10. 芯片使用、装配过程中注意防静电，戴接地防静电手镯，烧结、键合台接地良好；
11. 有问题请与供货商联系。